

PECVD

SPTのPECVD装置は、最先端のMEMSや半導体用途において、厚膜酸化膜および低応力SiNの安定した成膜を実現するよう設計されています。

Cetus, Capella

SPTのPECVD (プラズマ励起化学気相成長) システムは、シリコン酸化膜および窒化膜の高品質成膜を実現します。低ストレスかつ優れた膜厚均一性、ステップカバレッジにより、MEMSから光学コーティング、パッシベーション膜まで幅広い厚さレンジに対応可能です。

Applications:

- ✓ MEMS デバイス
- ✓ インクジェットヘッド
- ✓ TSV
- ✓ RF デバイス
- ✓ パワーデバイス
- ✓ LED
- ✓ 光学デバイス

FEATURES

SPTの高精度なPECVDが選ばれる理由



高速、そしてクラックレスな酸化膜成膜

MEMSや光導波路用途向けに、厚膜SiO₂を高速かつボイド・クラックなく成膜できます。



TSV構造に適した優れたステップカバレッジ

高アスペクト比・狭幅TSV構造に対しても、低温で高い被覆性を持つ酸化膜の成膜が可能です。



水素含有量の少ない高品質SiN膜

化合物半導体のパッシベーションに適した、緻密かつ低水素SiN膜を提供します。



MEMS膜構造に適した低応力SiN

超低ストレスかつ高い均一性を持つSiN膜は、MEMS膜応用にも最適です。



研究開発から量産まで対応可能な スケラブルなプラットフォーム

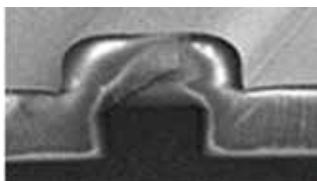
真空ロードロック型・クラスター型構成に対応し、幅広い製造ニーズにお応えします。

PERFORMANCE

厚膜酸化膜から低応力SiNまで ——結果が語る信頼性



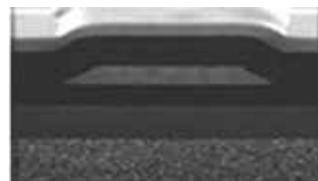
TSV構造における
ボイドレス酸化膜充填



厚膜シリコン酸化膜の成膜



低ストレスSiN成膜
(提供：ケンブリッジ大学)



アルミ配線上への
酸化膜コンフォーマル成膜

Specifications



Cetus



Capella

Process Module	Cetus	Capella
ウェーハサイズ (mm)	200	200
プラットフォーム	APX, DPX, VPX, CPX	APX, DPX, VPX, CPX
プロセス温度	Moderate	≤ 100°C
成膜可能材料	SiO ₂ , SiN, SiON, SiC	SiO ₂ , SiN

Platform	APX	DPX	VPX	CPX
用途	R&D	Prototype	Small Volume	Mass Production
チャンバー数	1	2	3	4
搬送ロボット	-	Atmospheric	Vacuum	Vacuum
ロボット・モーション	2-Axis	2-Axis	3-Axis	3-Axis
カセット数	0	2	1	2



SPP Technologies Co., Ltd. | SPT Microtechnologies USA, Inc.

Japan | USA | Germany | Taiwan

www.sptcorp.com

